

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертационной работе Максумовой Абай Маликовны на тему «Молекулярное наслаивание тонких пленок оксида молибдена, смешанных титан-молибденовых и алюминий-молибденовых оксидных пленок и их характеристика», представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по научной специальности
1.4.15. Химия твердого тела

Фамилия, имя, отчество	Васильев Владислав Юрьевич
Гражданство	РФ
Ученая Степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор химических наук, 02.00.21 – Химия твердого тела
Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент
Место работы:	
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, электронный адрес организации	630073, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, д. 20 https://www.nstu.ru/ , rector@nstu.ru
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», НГТУ
Наименование подразделения	Кафедра полупроводниковых приборов и микроэлектроники НГТУ
Должность	Профессор
Публикации по специальности 1.4.15. Химия твердого тела:	
1. Васильев, В.Ю. Состав, структура и функциональные свойства тонких пленок нитрида кремния, выращенных атомно-слоевым осаждением для применений в микроэлектронике (Обзор 25 лет исследований) / В.Ю. Васильев // Журнал Структурной Химии. – 2022. – Т. 63. – № 7. – С. 93866. 2. Vasilyev, V.Y. Review-Atomic Layer Deposition of Silicon Dioxide Thin Films / V.Y. Vasilyev // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2021. – V. 10. - № 5. – ID. 053004. 3. Васильев, В.Ю. Атомно-слоевое осаждение тонких пленок диоксида кремния для микро- и нанoeлектроники. Часть 4. Температурные зависимости скоростей осаждения и плотности пленок / В.Ю. Васильев // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2021. – Т. 1. – № 181. – С. 18-26. 4. Васильев, В.Ю. Атомно-слоевое осаждение тонких пленок диоксида кремния для микро- и нанoeлектроники. Часть 5. Особенности роста пленок в соответствии с моделями гидроксидов на кремнезем / В.Ю. Васильев // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2021. – Т. 2. – № 182. – С. 10-16. 5. Васильев, В.Ю. Атомно-слоевое осаждение тонких слоев нитрида кремния для микро- и нанoeлектроники / В.Ю. Васильев // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2020. – Т. 1. – № 177. – С. 31-41.	

6. Васильев, В.Ю. Атомно-слоевое осаждение тонких плёнок диоксида кремния для микро- и нанoeлектроники. Часть 3. Процессы с азотсодержащими предшественниками / В.Ю. Васильев // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2020. – Т. 1. – № 177. – С. 19-30.
7. Васильев, В.Ю. Конформность роста тонких слоев из газовой фазы на рельефных микро- и наноструктурах. Часть 3. Процессы атомно-слоевого осаждения / В.Ю. Васильев // Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. – 2020. – Т. 3. – № 179. – С. 26-37.
8. Vasilyev, V.Y. Review - Mechanical Stress in Chemically Vapor Phase Deposited Boron- and Phosphorus-Contained Silicate Glass Thin Films: A Review / V.Y. Vasilyev, G. Kittilsland // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2020. – V. 9. - № 4. – ID. 043003.

Официальный оппонент


Подпись

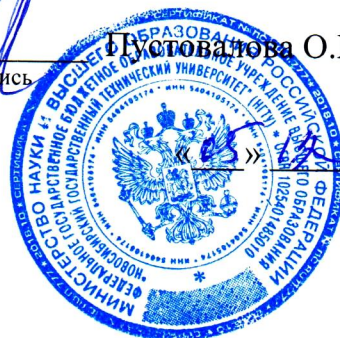
Васильев Владислав Юрьевич

Сведения верны:

Начальник отдела кадров НГТУ


Подпись

Гусева-Това О.К.



2023